



**Toshiba annonce de nouveaux MOSFET canal-N 100V
pour applications automobiles**

Nouveaux dispositifs à très haut rendement, pour la première fois en boîtier
SOP Advance (WF)

Düsseldorf, Allemagne, 16 décembre 2019 - Toshiba Electronics Europe lance ses tout premiers MOSFET de puissance canal-N 100V, destinés aux applications automobiles, en petit boîtier SOP Advance (WF) montables en surface. Conçus spécialement pour les systèmes 48V modernes, ces dispositifs sont bien adaptés aux convertisseurs boost (survolteur) présents dans les alternateurs-démarrateurs intégrés (ISG pour Integrated Starter Generator en anglais) et les phares à LED, ainsi que dans les variateurs de vitesse, les régulateurs à découpage, et les commutateurs de charge.

Les XPH4R10ANB et XPH6R30ANB améliorent le rendement des systèmes automobiles grâce à leur faible résistance à l'état passant ($R_{DS(ON)}$). En pratique, le XPH4R10ANB offre une résistance à l'état passant de seulement 4,1 mΩ, ce qui permet de réduire considérablement les pertes. Les deux dispositifs sont logés en boîtier SOP Advance (WF) à flans mouillables. Ce type de petit boîtier est éprouvé pour les applications automobiles 48V, et il est compatible avec les machines AOI (Automated Optical Inspection, ou inspection optique automatisée) qui servent à contrôler la qualité des joints de soudure.

Les deux dispositifs font partie de la série U-MOSVIII-H de Toshiba et offrent une tension drain-source (V_{DS}) de 100V et une température maximale de fonctionnement de 175°C.

Translator's note : shouldn't source text say ' V_{DS} ' and not ' V_{DSS} ' for drain-source voltage?

Le XPH4R10ANB supporte un courant de drain continu maximum de 70A, et 210A en mode pulsé. Pour le XPH6R30ANB les valeurs sont respectivement de 45A et 135A.

Les deux dispositifs sont aujourd'hui produits en série et sont livrables en quantités de production.

Suivez le lien ci-dessous pour en savoir plus sur la gamme de MOSFET Toshiba pour l'automobile :

<https://toshiba.semicon-storage.com/eu/product/mosfet/detail.XPH4R10ANB.html>

<https://toshiba.semicon-storage.com/eu/product/mosfet/detail.XPH6R30ANB.html>

###

A propos de Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) est la division européenne de composants électroniques de [Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation](#) (Toshiba). TEE offre aux consommateurs et aux entreprises européennes un large choix de disques durs (HDD) et de semiconducteurs innovants pour les applications automobiles, industrielles, IoT (Internet of Things, ou Internet des objets), de contrôle d'axe, de télécommunications, de réseaux, de grand-public ou d'électro-ménager. Le large catalogue de la société comprend des CI sans-fil, des semiconducteurs de puissance, des microcontrôleurs, des semiconducteurs optiques, des ASSP et des dispositifs discrets allant de diodes à des CI logiques.

TEE a son siège à Düsseldorf en Allemagne, et possède des filiales en France, en Italie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni, assurant la conception, la fabrication, le marketing et les ventes. Le président de la société est M. Tomoaki Kumagai.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de Toshiba Electronics Europe : www.toshiba.semicon-storage.com.

Personne à contacter pour les questions concernant la publication:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

E-mail:

Pour des informations concernant la publication, contactez:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0) 1932 822 832

E-mail: MShrimpton@teu.toshiba.de

Publié par:

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0) 1582 390980

Web: www.publitek.com

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com

Décembre 2019

Réf : 7245_A